Seria: MATEMATYKA-FIZYKA z. 43

Nr kol. 795

I. FLAKUS, J. NORWICZ, J. PLEWA, J. BOTOR, L. DZIEWIDEK

OTRZYMYWANIE I ROZKŁAD TERMICENY STAŁYCH PŁYTKOWYCH ŹRÓDEŁ DOMIESZEK FOSFORU DO KRZEMU

<u>Streszczenia</u>. W Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej opracowano technologię wytwarzania stałych płytkowych źródeł domieszek fosforu do krzemu. W wyniku syntezy jednozasadowego fosforanu amonu NH₄H₂PO₄ i kwasu metakrzemowego SiO₂. 1/2 H₂O otrzymano źródło zawierające pirofosforan SiP₂O₇ z minimalną ilością Si₂P₂O₉, co zapewnia dobrą wytrzymałość mechaniczną i termiczną w warunkach pracy. W czasie termicznego rozkładu źródła fosfor wydziela się w postaci dimeru P₄O₁₀, przy czym prędkość rozkładu jest kontrolowana przez dyfuzję produktów poprzez warstwę stałego produktu powstające go na nieprzeresgowanym jędrze.

WSTEP

W Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach opracowano, przy współpracy z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych 🖉 w Warszawie, technologię wytwarzania stałych płytkowych źródeł domieszek fosforu do krzemu [1]. W wyniku prowadzonych prac otrzymano źródło w postaci płytki ceramicznej, której składnikiem aktywnym, ulegającym rozkładowi w temperaturze pracy, jest mieszanina pirofosforanów krzemu. Własności źródeł oceniano w świetle wyników różnorodnych badań fizykochemicznych. Szczególny nacisk położono na analizę procesu termicznego rozkładu źródeł. Wyniki wykonanych badań korelowano z rezultatami pomiarów rezystancji powierzchniowej i głębokości położenia złącza dla krzemu domieszkowanego z płytkowych źródeł fosforu i wartościami parametrów otrzymanych w ten spoeób struktur diodowych. Parametry struktur diodowych są identyczne – z parametrami struktur otrzymanych przy użyciu przemysłowej techniki dyfuzji, z wykorzystaniem ciekłego źródła domieszki fosforu POCl_z. Stałe płytkowe źródła domieszek fosforu, których zalety były już wielokrotnie podkreślone i, 2, 3, 4, 5, wykazują dobrą zdolność domieszkowania krzemu fosforem na poziomie wymaganym przez Unitrę CEMI w Warszawie i moga być stosowane wielokrotnie do dvfuzii.

OTRZYMYWANIE STAŁYCH PŁYTKOWYCH ŹRÓDEŁ DOMIESZEK FOSFORU

Jak wspomniano, aktywnym składnikiem stałych płytkowych źródeł domieszek fosforu do krzemu jest mieszanina pirofosforanów krzemu SiP_0-1 Si_P_O_. Pirofosforany te otrzymuje się w wyniku reakcji syntezy, co było już wcześniej przedstawione [1]. Substratami są spektralnie czyste jednozasadowy fosforan amonu $NH_4H_2PO_4$ i kwas metakrzemowy SiO $_2$. $\frac{1}{2}H_2O$ produkcji krajowej, Instytutu Chemii Nieorganicznej Politechniki Śląskiej. Warunki syntezy przez zwiększanie szybkości ogrzewania, skracanie czasu wygrzewania w temperaturze syntezy i zwiększenie ilości P₂O₅ w stosunku do ilości stechiometrycznej dobrano tak, aby zminimalizować tworzenie się niekorzystnej fazy Si_pP_pO_p. Jest ona niepożądana, gdyż zawiera mniejszą ilość fosforu oraz ulega stopieniu w temperaturze zbliżonej do temperatury stosowanej przy dyfuzji fosforu do krzemu. Kwestię powtarzalności wyników syntezy należy uznać za opanowaną. Przeprowadzono do tej pory około 60 procesów syntezy, uzyskując identyczne wyniki.

Na podstawie badań rentgenodyfraktometrycznych, wykonanych na dyfraktometrze rentgenowskim DRON-1,5 w warunkach pracy U = 38 kV, I = 10 mA, CuK α , stwierdzono, że w wyniku syntezy powstaje głównie faza SiP₂O₇ identyczna z tą, jaką T.Y. Tien i F.A. Hummel [6] nazwali fazą niskotemperaturową α , a F. Liebau, G. Bissert, N. Köppen faza A-III [7, 8, 9, 10, 11]. W minimalnej ilości powstaje faza $2SiO_2$.P₂O₅ identyczna z tą, jaką zidentyfikowali T.Y. Tien i F.A. Hummel [6] i jaką F. Liebau, G. Bissert, N. Köppen nazwali fazą C [7, 8, 11]. Faza niskotopliwa α SiP₂O₇ przechodzi w sposób odwracalny w fazę wysokotemperaturową w temperaturze 1030°C (1303 K), [6, 12]. Faza /⁵ topi się kongruentnie w 1120°C (1393 K), two-rząc związek SiO₂.P₂O₅ i bogaty w krzemionkę stop.

Aby polepszyć wytrzymałość mechaniczną źródeł, do mieszaniny otrzymanych w wyniku syntezy pirofosforanów dodaje się dwutlenek krzemu, spektralnie czysty, w postaci amorficznej, w stosunku wagowym 70% SiP₂O₇ 130% SiO_o. Skład ten, jak stwierdzono, jest optymalny z punktu widzenia własności mechanicznych źródeł, jak i ich zdolności domieszkowania fosforem, Tak przygotowaną mieszaninę poddaje się procesowi prasowania na zimno, dla otrzymania płytek, a następnie spieka się w atmosferze argonu. Zaproponowana technologia jest o wiele prostsza, bardziej ekonomiczna i nie wymaga stosowania dość skomplikowanej aparatury, jaka jest potrzebna do prasowania na gorąco w atmosferze obojętnaj. Eliminuje się również proces cięcia materiału na płytki, przy użyciu specjalnej piły diamentowej [1]. Po procesia spiekania oraz po wielogodzinnym użytkowaniu źródeł do domieszkowania nie stwierdzono istotnych zmian w ich składzie fazowym. Wyniki te sa zgodne z analogicznymi badaniami przeprowadzonymi przez N.Jonesa dla źródeł PH 1050 firmy Carborundum Company [13].

Otrzymywanie i rozkład termiczny...

W celu stwierdzenia, czy proces technologiczny nie powoduje wprowadzenia do źródeł niepożądanych zanieczyszczeń po każdym etapie technologicznym przeprowadzono kontrolną analizę składu chemicznego źródeł i zawartych w nich śladowych pierwiastków za pomocą fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej. Badania prowadzone na spektrometrze rentgenowskim sekwencyjnym Philips 1450 AHP w warunkach pracy U = 50 kV, I = 20 mA, PC, C, Stwierdzono, że przy narzuconym, dość ostrym reżimie czystości podczas wytwarzania stałych, płytkowych źródeł decydujący wpływ na czystość produktu końcowego ma jakość substancji wyjściowych.

KINETYKA ROZKŁADU TERMICZNEGO ŹRÓDEŁ

Badania termograwimetryczne rozkładu termicznego źródeł domieszek fosforu wykonano w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, przy użyciu termowagi Mettler TA1. Badanie wykonano w próżni, w związku z czym wyznaczona tzw. "proceduralna temperatura początku rozkładu" pdt [14] będzie nieco niższa niż przy ciśnieniu atmosferycznym. Wyniki badań termograwimetrycznych próbki o masie 0.4448 g i wymiarach 11 x 11 x 2 mm ogrzewanej w próżni niższej niż p = 2. 10^{-5} mm Hg. (2,66 10^{-3} Pa) z szybkością /3= = 4 K/min do temperatury 1115°C (1389 K) przedstawia rys. 1. Z krzywej ubytku masy wynika, że w warunkach pomiaru źródło zaczyna się rozkładać w temperaturze pdt = 972°C (1245 K). Przebieg krzywej prędkości ubytku masy DTG wskazuje, że największa szybkość rozkładu osiąga się w temperaturze T_{may} = 1087⁰C (1360 K). W celu określenia mechanizmu procesu rozkładu, tj. wyznaczanie etapu najwolniejszego tego procesu, wykorzystano przedstawiony w [15] sposób rozróżniania modeli kinetycznych dla danych nieizotermicznych. W odpowiednio dobranym układzie współrzędnych różne rodzaje modeli kinetycznych generują krzywe kinetyczne różnego kształtu. Jeżeli dane doświadczalne, uzyskane w warunkach liniowego wzrostu temperatury przedstawić w układzie współrzednych

$$\frac{DDTG}{DTG^2} - \hbar \frac{E}{RT^2} \cdot \frac{1}{DTG} \qquad w \text{ funkcji } TG, \qquad (1)$$

to ułożą się one wzdłuż odpowiednich krzywych charakterystycznych dla danego typu kontroli przebiegu reakcji. Na rys. 2 przedstawiono krzywe odpowiadające zależmości (1), dotyczące reakcji kontrolowanych przez zarodkowanie (F), reakcję chemiczną (R) i dyfuzję (D). Indeksy 1, 2, 3 określają odpowiednio symetrię jedno-, dwu- i trójwymiarową. Potrzebną wartość energii aktywacji E oblicza się uprzednio na podstawie wyników pomiarów. Tylko ta wartość energii aktywacji jest prawdopodobna, dla której zależność (1) odpowiada krzywym modelowym.

Obliczone wartości stałych kinetycznych rozkładu i termicznego i źródła domieszki fosforu zestawiono w tablicy 1.A + stała przedeksponencjalna rów-







$$\frac{DDTG}{DTG^2} - \frac{\beta}{RT^2} \cdot \frac{1}{DTG} \quad w \text{ funkcji TG}$$



Rys. 3. Rozkład stałego płytkowego źródła domieszek fosforu kontroloweny przez dyfuzję produktów poprzez warstwę produktu stałego

Tablica 1

Wartości parametrów kinetycznych oraz niektóre pomiary statystyczne dopasowania równania $\ln(g(\alpha)) - 2 \ln T = A - \frac{E}{R} + \frac{1}{T}$ do danych doświadczalnych uzyskanych dla rozkładu termicznego stałych płytkowych źródeł domieszek fosforu

Model	A	E R	$r^2(y-\overline{y})^2$	s ² (y)	r	
F ₁	13,428	43117,110	32,959	$1,220.10^{-2} \\3,031.10^{-3} \\1,339.10^{-3} \\1,202.10^{-2} \\1,211.10^{-2} \\1,214.10^{-2} \\4,822.10^{-2} \\4,846.10^{-2} \\4,854.10^{-2} \\4,854.10^{-2} \\$	0,995039	
F ₂	-1,468	20244,058	7,266		0,994414	
F ₃	-6,433	12619,708	2,823		0,993658	
R ₁	13,258	42901,856	32,631		0,995064	
R ₂	12,649	43009,341	32,795		0,995052	
R ₃	12,272	43045,233	32,849		0,995048	
D ₁	42,879	88432,704	138,646		0,995534	
D ₂	42,299	88575,831	139,095		0,005329	
D ₃	40,833	88623,758	139,246		0,995326	

nania Arrhaniusa, R - stała gazowa, r - współczynnik korelacji s²(\hat{y}) - wariancje przeciętnego pomiaru, g(α) - postać równania modelowego w funkcji stopnia przereagowania. T - temperatura bezwzględna. Jedynie dla E/R # 88600 krzywa (1) posiada przebieg odpowiadający krzywej modelowej (rys. 3). Należy przyjąć, że rozkład termiczny stałych płytkowych źródeł domieszek fosforu jest kontrolowany przez proces dyfuzji (D₂, D₃). Wyboru pomiędzy modelami można dokonać uwzględniając postać próbki. Badane źródła wykonane są ze sprasowanych w prostopadłościan kulistych ziaren, dlatego naturalna jest hipoteza, że proces rozkładu jest limitowany prędkością dyfuzji produktów rozkładu poprzez warstwę produktu stałego, powstającę na nieprzereagowanym rdzeniu kulistym.

Proces rozkładu może być w przybliżeniu opisany zależnością

$$\frac{d\sigma}{dt} = 1,919 \ 10^{23} \exp\left(-\frac{88623}{7}\right) \ . \ \frac{2}{3} \frac{1}{(1-\sigma)^{-1/3}-1} \left[\frac{1}{\min}\right]$$

EMISJA ZWIĄZKÓW FOSFORU

Badanie emitowanych z próbki par i gazów przeprowadzono na spektrometrze mas z komórką Knudsena. Dokładna budowa i zasada działania spektrometru IMS-01 BK jest opisana we wcześniejszych pracach [16, 17]. Pozwala on na identyfikację rodzaju emitowanych substancji i określenie ich prężności częstkowych.

Do pomieru użyto nierozbieralnych kwarcowych komórek Knudsena w kształcie baniek o średnicy 15 mm, wysokości 15 mm i średnicy otworka efuzyjnego około 1 mm. Próbki po sproszkowaniu wsypywano do komórki Knudsena przez otworek efuzyjny. Wstępne próby przeprowadzono również w rozbieralnych komórkach tantalowych. Stwierdzony po pomiarze przyrost masy komórki oraz obecność w widmie mas jedynie jonów fosforu wskazuje na reakcję materiału badanego z tyglem. Stosowano następujące parametry pracy spektrometru mas: napięcie jonizujące 70 V, prąd jonizujący 0,3 mA, napięcie powielacza 1,4 kV, zdolność rozdzielcza 1300, napięcie przyspieszające 8 kV. Inne parametry ustawiono tak, aby zapewnić optymalne warunki pomiaru dla najcięższego rejestrowanego jonu tzn. dla jonu P₄0₁₀ o masie M = 284.

Watepna identyfikację widma mas przeprowadzono dla proszku – o składzie 70% i SiP₂O₇ i 30% SiO₂ używanego do produkcji płytek ceramicznych. W czasie identyfikacji ogrzewano próbkę do temperatury 967°C (1240 K) i przeprowadzono rejestrację widma mas w zakresie M = 10-600 przy otwartej, a następnie przy zasłoniętej przesłonie pomiędzy komórki Knudsena a źródłem jonów. Identyfikację powtórzono na innej próbce, rejestrując jedynie jony, których natężenie zmieniało się wraz z przesłonięciem otworu efuzyjnego. Pomiar wykonano w temperaturze 943°C (1216 K) i 990°C (1263 K), ogrzewajec próbki przez okres 2 godzin w każdej z temperatur. Za jony pochodzące od próbki przyjęto te, których natężenie zmienieżo się po przysłonięciu otworu sfuzyjnego, przy czym stosunek natężeń ich prądów jonowych słabo zmieniał sie z temperaturę. Pomiary emisji związków fosforu wykonano dla uprzednio sproszkowanych materiałów w zakresie temperatury $777^{\circ}C$ (1050 K) - 977°C (1250 K), zmieniajęc temperaturę skokowo co 50° i wytrzymujec próbki w każdej z temperatur przez 40 min. Pomiary wykonywano zarówno w trakcie ogrzewania, jak i chłodzenia próbki.

Rejestrowano prądy jonowe pięciu jonów, mianowicie: $P_4O_{10}^+$, $P_3O_7^+$, $P_2O_5^+$, PO^+ , P_2^+ . Jako wynik pomiaru przyjmowano prąd, który ustalał się pod koniec okresu wygrzewania.

Dodatkowo przeprowadzono pomiar izotermiczny w temperaturze 972°C (1245 K) (w czasie 4 h 40°) rejestrując prądy sześciu jonów mających największy udział w widmie mas, to jest: $P_4O_{10}^+$, $P_3O_7^+$, PO_2^+ , PO^+ , P_2^+ , $P_2O_5^+$.

Wyniki identyfikacji widma mas przedstawiono w tablicy 2. Symbol chemiczny poszczególnych jonów ustalono przez kombinowanie różnych składów atomów fosforu i tlenu tak, aby liczba masowa otrzymanaj cząsteczki była równa liczbie masowej rejestrowanego jonu. W czasie wygrzewania próbki w ustalonej temperaturze obserwowano ciągły spadek natężenia prądów jonowych. Zgodnie z danymi zawartymi w pierwszej części niniejszego opracowania, można to wyjaśnić brakiem równowagi termodynamicznej pomiędzy fazą gazową a skondensowaną, na skutek dyfuzji produktów rozkładu przez werstwę stałego produktu. Jon $P_4O_{10}^+$ jako najcięższy został uznany za jon molekularny, to znaczy powstały w wyniku jonizacji molekuły P_3O_{10} . Pozostałe jony mogą pochodzić z fragmentacji molekuły P_4O_{10} lub też z fragmentacji i jonizacji produktów termicznej dysocjacji tejże molekuły. Je-

Ta	bl	ic	a	2
----	----	----	---	---

			Próbka				
м	Jon	1263	к	1216 K		1262 K	
		widmo mas %	tło	widme mas %	tło	widmo mas %	
284	P40+10	100	34	100	24	100	
205	P307	76	11	85	7	100	
142	P205	2,8	26	3,3	20	3,1	
126	P204	0,28	30	0,41	23	1.1.1	
94	P202	0,22	38	-	100	-	
63	P02	26	21	24	15	-	
47	PO ⁺	51	20	58	35	52	
124	P4	1,26	82	-	100	_	
93	P3	0,12	75	0,1	80	-	
63	P2+2	12,9	60	12	65	8,7	
31	P ⁺	1,9	58	1,6	56	-	
80	-	1,2	1,2	1,58	25		
54	-	0,71	33	1,12	52	1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
45	-	0,58	5	0,95	8	-	

Wyniki identyfikacji widma mas rozkładu źródeł domieszek fosforu

żeli założy się, że w parach występują hipotetyczne molekuły P4⁰10, P3⁰7 i 0₂ powstałe w wyniku reakcji:

$$3 P_4 0_{10} = 4 P_3 0_7 + 0_2,$$
 (2)

to stała równowagi tej reakcji dana jest równaniem:

$$\kappa_{p} = \frac{P_{p_{3}}O_{7} P_{0_{2}}}{P_{p_{4}}O_{10}}$$
(3)

Ponieważ w komórce Knudsena skład fazy gazowej jest wyznaczony przez rozkład pirofosforanu krzemu, to stosunek ciśnień cząstkowych P₀₂/P₃₀₇ jest stały. Wartość tej stałej jest wyznaczona przez stechiometrię reakcji (2) i proces efuzji. Ciśnienie tlenu w równaniu (3) może być więc wyeliminowane przez zastosowanie zależności:

$$P_{0_2} = P_{p_3} O_7 \quad \text{const.} \tag{4}$$

Niech w wyniku jonizacji z molekuł P₄0₁₀ powstają jony P₄0⁺ a z molekuł P₃0₇ jony P₃0⁺7. Stałą ciśnieniową (3) można zastąpić stałą prądową

 $Ky = \frac{J_{p_3}^5 O_7^+}{J_{p_4}^3 O_{10}^+}.$ (5)

Po uwzględnieniu w równaniu (3) równań (5), (4) otrzymuje się zależność łącząca prądy jonowe $J_{p_3O_7}^+$ i $J_{p_4O_{1O}^+}^+$ w czasie pomiaru izotermicznego:

$$J_{p_{3}0_{7}^{+}} = Ky^{1/5} J_{p_{4}0_{10}^{+}}^{3/5_{+}}$$
(6)

Po obustronnym podzieleniu przez J_{P4}0⁺ i zlogarytmowaniu powyższego równania, otrzymuje się:

$$\log (J_{p_30_7^+}) = (\frac{3}{5} - 1) \log J_{p_40_{10}^+} + \log Ky^{1/5}.$$
 (7)

Dla innych jonów występujących w widmia mas można przeprowadzić podobne rozumowanie, prowadzące do równania postaci:

$$\log (\mathbf{Ji}) \ \mathbf{J}_{\mathbf{p}_{4}\mathbf{O}_{1\mathbf{O}}^{+}} = (\frac{\mathbf{n}}{\mathbf{m}} - \mathbf{1}) \ \log \ \mathbf{J}_{\mathbf{p}_{4}\mathbf{O}_{1\mathbf{O}}^{+}} + \mathbf{C}_{\mathbf{1}}. \tag{8}$$

gdzie:

C_i - stała,

n - liczba cząsteczek P₄0₁₀ po lewej stronie równania reakcji,

m – liczba cząsteczek po prawej stronie równania reakcji.

Badanie współczynników korelacji i regresji równania (8) dla róźnych składników widma mas pczwala ocenić pochodzenie jonów. Jeżeli dany jon powstaje w wyniku fragmentacji molekuły P₄O_{1O}, to należy oczekiwać współczynnika korelacji bliskiego zeru. W przeciwnym przypadku wartość współczynnika regresji może służyć do weryfikacji założeń dotyczących reakcji w fazie gazowej i procesu jonizacji. Jeśli np. miałaby miejsce reakcje (2), to współczynnik regresji równania (8) powinien wynosić

$$a = (\frac{3}{5} - 1) = -0, 4.$$





Zależność czasową obserwowanych prądów jonowych podczas pomiaru izotermicznego przedstawia rys. 4. Wykorzystując wyniki przedstawione na rysunku 4 sporządzono wykres obserwowanych prądów jonowych we współrzędnych: $\log(J_i/J_{P_4}O_{10}^+)$ w funkcji $(\log J_{P_4}O_{10}^+)$ przedstawiony na rys. 5. Metodą najmniejszych kwadratów znaleziono współczynniki regresji i korelacji równania (8) dla następujących stosunków prądów jonowych:

$$\mathbf{J}_{p_{2}^{+}(\mathbf{J}_{p_{4}}\mathbf{O}_{10}^{+}; \mathbf{J}_{p0^{+}}) \mathbf{J}_{p_{4}}\mathbf{O}_{10}^{+}; \mathbf{J}_{p_{3}}\mathbf{O}_{7}^{+}(\mathbf{J}_{p_{4}}\mathbf{O}_{10}^{+}); \mathbf{J}_{p_{2}}\mathbf{O}_{5}^{+}(\mathbf{J}_{p_{4}}\mathbf{O}_{10}^{+}; \mathbf{J}_{p0^{+}_{2}}) \mathbf{J}_{p_{4}}\mathbf{O}_{10}^{+}; }$$

Wyniki są przedstawione w tablicy 3.

Dla jonów P_2^+ i PO^+ należy przyjąć hipotezę o występowaniu korelacji przy poziomie ufności 0,999 [18]. Jony P_2^+ pochodzą prawdopodobnie z jonizacji polimerów fosforu, hipoteza ta wydaje się prawdopodobna, ponieważ obserwuje się jony odpowiadające polimerom fosforu od P do P_A (ta-



Rys. 5. Zmiana stosunków prądów jonowych wybranych jonów związków fosforu w czasie izotermicznego rozkładu źródła domieszek foeforu – T = 1245 K

Tablica 3

Wartość współczynników regresji i korelacja równ. (8) dla izotermicznego rozkładu źródła domieszek fosforu

Jon	Liczba punktów	Współczynnik regresja	i równ. (8) korelacja	Prawdopodobieństwo hipotezy o braku korelacji (wg [18])		
P307	11	-0,023	-0,397	>0,1		
P205	7	+0,014	+0,204	>0,1		
P02+	10	-0,063	-0,511	>0,1		
P2+2	10	-0,199	-0,952	>0,001		
P0 ⁺	10	-0,166	-0,941	>0,001		

bela 2). Gdyby wolny fosfor tworzył się w wyniku termicznej dysocjacji P₄O₁₀, mp. wg reakcji

$$P_40_{10} = 2 P_2 + 50_2,$$
 (9)

to współczynnik regresji zgodnie z (8) powinien wynosić

 $a = \frac{1}{7} - 1 \approx -0,857.$



Rys. 6. Wyniki rozkładu stałego źródła fosforu w warunkach zmiany temperatury

I. Flakus i inni

Znaleziony współczynnik regresji wynosi a = -0,199, czyli jego wartość jest znacznie mniejsze od wartości obliczonej. Przyjęto, że wolny fosfor powstaje poza komórkę Knudsena w wyniku reakcji tlenków fosforu z tantalowymi ekranami. Wskazuje to na również wcześniej wspomniene doświedczenie z tyglem tantelowym. Podobnie wysoki współczynnik korelacji dle prędu jonowego odpowiedejącego jonom PC⁺ wskazuje ne to, że fragmentacja molekuł P₄0₁₀ nie może być ich jedynym źródłem.

Z drugiej strony stwierdzone wartość współczynnika regresji (a=-0,166) różne od przewidywanej wyklucza hipotezę, że jedynym źródłem prekursorów jonów PO^+ jest proces termicznej dysocjacji częsteczek P_AO_{10} .

 $P_4 O_{10} = 4P0 + 3O_3; a = -0,857$ (10)

Dla jonów $P_3O_7^+$, $P_2O_5^+$, PO_2^+ można przyjąć hipotezę o braku korelacji, dlatego ich pochodzenie przypisano wyżącznie fragmentacji częstek P_BO_{10} .

Jak wynika z wyżej przedstawionej analizy wyników pomiaru izotermicznego, pary nad pirofosforanem krzemu składają się prawie wyłącznie z częsteczek dimerów P_4O_{10} a obserwowane jony z wyjętkiem jonów P_2^+ i częściowo jonów $P0^+$, powstaję w wyniku jonizacji i fragmentacji tych częsteczek.

Przyjęty schemat jonizacji można przedstawić w postaci następujęcego wykresu



Na rys. 6 przedstawiono wyniki pomiaru nieizotermicznego dle sproszkowanego źródła.

Prężność par P_4O_{10} wyliczono na podstawie pomiarów prędów jonowych J $_{P_4O_{10}}^+$ zmierzonych pod koniec każdego z okresów izotermicznych i ubytku masy próbki w czesie pomiaru.

Do obliczeń stosowano następujące równanie

$$P = k . J . T,$$
 (11)

gdzie:

P - ciśnienie w komórce Knudsena,

3 - rejestrowany pred jonowy,

k - staža,

T - temperatura bezwzględna,

Otrzywywanie i rozkład termiczny...

technologii z uzy-

Stałą k wyznaczono za pomocą równania:

$$= \sqrt[n]{\frac{M}{2 RT}} \cdot S \cdot \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{T} Jdt \Big|_{\Delta m}^{-1}, \qquad (12)$$

 $\Delta m = ubytak maay (4,7 mg przy m_o = 0,1905 g),$ $M = ciężar częsteczkowy, M_{p_4O_{1O}} = 284,$ R = atała gazowa, S = powierzchnia otwerka efuzyjnego (0,78 mm²), $\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{T} Jdt = obliczeno na podstawia pomiarów (3,654 . 10⁻⁵).$

Wyniki obliczeń można przedstawić w postaci zależności

$$lg P_4 O_{10} \stackrel{+}{=} 0, 14 = -\frac{15150}{T} + 11,76 \quad (Pa), \quad (13)$$

która określa prężność par P40₁₀ nad stałym źródłem dla zakresu temperatur 1050-1250 K w czasie pomiarów,

PODSUMOWANIE

(a) weekland w.W.: Thereal Kernods of Analysis, J. Wiley and Sone, New Stała źródła domieszek fosferu wykonana przez Instytut – Fizyki Politechniki Ślęskiej zostały poddana badaniom mającym na calu określenie warunków ich dysecjacji termicznej w temperaturach zbliżonych do stosowanych obecnie w procesie demieszkowanie krzemu fosforem, Stosowana technologia pozwoliża otrzymać źródło, zbudowana głównie z SiP₂O₂ z minimalną jedynie ilościę. Si₂P₂O₀, co zepewnie większę wytrzymełość mechaniczną źródel w warunkach podwyższonej temperatury. Zastosowany proces prasowano na zimno i spiekanie sprasowanego materiału w atmosferza argenu jest precesem žatwiejszym niż stosowany uprzednio proces prasowania na gorąco wraz z cięciem strzymanego wyrobu na płytki. Badania rozkładu termicznego źródła wykonano w Instytucie Metali Nieżelaznych wskazuję,że zasadnicżym gazowym produktem rezkładu jest dimer P₄0₁₀, Proces rozkładu jest kontrolowany przez dyfuzję preduktów poprzez warstwę produktu stałego powstającago na nieprzereagowanym jędrze. Dla wstępnej oceny prędkości reakcji rozkładu źródła oraz prężności par P₄0₁₀ nad źródłam można wykorzystać podane w pracy równania empiryczne. Dane te odnoszę się do określonych warunków doświadczalnych.

Przedstawione rezultaty sugerują możliwość zastosowania opracowywanych przez Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej stałych płytkowych źródeł domieszek fosforu do krzemu w miejsce obecnie stosowanej technologii z użyciem ciekłego POCl_z.

LITERATURA

[1]	Flekus	I.,	Kończak	S.:	Materiały	Elektronic	czne,	25,	1979,	40.
-----	--------	-----	---------	-----	-----------	------------	-------	-----	-------	-----

- [2] Coldsmith N., Olmstead J., Scotty J.: RCA Review, 28, 1967, 344.
- [3] Rupprecht D., Stach J.: J. Electrocham. Soc., 120, 1973, 1266.
- [4] Stach J., Turley A.: J. Electrochem. Soc., 121, 1974, 722.
- [5] Flakus I., Kończak S.: Materiały z konferencji Fizyka dla przemysłu. Wrzesień 1980, Kraków.
- [6] Tien T.Y., Hummel F.A.: J. American Caramic Soc., Vol. 45, No 9.1962, 422.
- [7] Liebau F., Bissert G., Koppen N.: Z. anorg. allg. Chem., 359, 1968, 113.
- [8] Liebau F., Bissert G.: Bull. Sos. Chim. Fr., 1968, 1742 (Spec. No).
- [9] Bissert G., Liebau F.: Naturwissenschaften, 56, (4), 1969, 212.
- 10 Liebau F., Hesse K.F.: Naturwissenschaften, 56, (12) 1969, 634.
- [11] Corbridge D.E.C.: The structural chemistry of phosphorus, Amsterdam 1974.
- [12] Procesy technologiczne w elektronice późprzewodnikowej. WNT, Warezewa 1980, 305.
- [13] Jones N.: J. Electrochem. Soc., 123, 1976, 1565.
- [14] Wendtlend W.W.: Thermal Methods of Analysis, J. Wiley and Sons, New York 1972.
- [15] Plewa I., Norwisz I., Hajduk N., Romańska M.: Thermochim. Acta, 46, 1981, 217.
- [16] Golonka J., Botor J., Dulat M.: Rudy Metale Nieżelezne, 21, (9) 1976, 315.
- [17] Ibid., 21 (10), 1976, 330.
- [18] Volk W.: Statystyka stosowania dla inżynierów. WNT, Warszawa 1973.

Recenzent: doc. dr Zdzieław Librant

Wpłynęło, 21.09.1982 r.

ПОЛУЧЕНИЕ И ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ТВЕРДОГО ПЛИТОЧНОГО ИСТОЧНИКА ПРИМЕССИ ФОСФОРА К КРЕМНИЮ

Резюме

В Институте Физики Силезского Полетехнического Института разработано технологию получения твёрдых плиточных каточников примессё фосфора к кремнию. В результате синтеза одноосновного фосфата аммониевого $NH_4H_2PO_2$ к метакремневой кислоты $SiO_2.1/2$ H_2O получено источник фосфора, содержащий пирофосфат кремния. SiP_2O_2 с минимальной примессью $Si_2P_2O_9$, который отличается хорошным механическими и термическими свойствами в условиях работы источника. Во время термического разложения фосфор испаряется в форме димера P_4O_{10} . Скорость разложения зависит от окорости диффузии чесез пласт твёрдого продукта разложения, который возникает на твёрдом корие субстрата.

SYNTHESIS AND THERMAL DISSOCIATION OF SOLID LAMELLAR SOURCES OF PHOSPHORUS ADMIXTURES TO SILICON

Summary

A technology for the production of solid lamellar sources of phosphorus admixtures to silicon has been elaborated at the Institute of Physics at Silesian Technical University. As a result of a synthesis of the monobasic ammonium phosphate $NH_4H_2PO_4$ and the methasilicate acid SiO_2 . 1/2 H_2O a source has been obtained containing pyrophosphate SiP_2O_7 with a small amount of $Si_2P_2O_9$, which assures good mechanical and thermal strength under operational cinditions. During thermal source dissociation phosphorus evaporates in the form of a P_4O_{1O} dimer, while the dissociation rate is controlled by diffusion of the products through the layer of a solid product formed on the unreacted nucleus.